

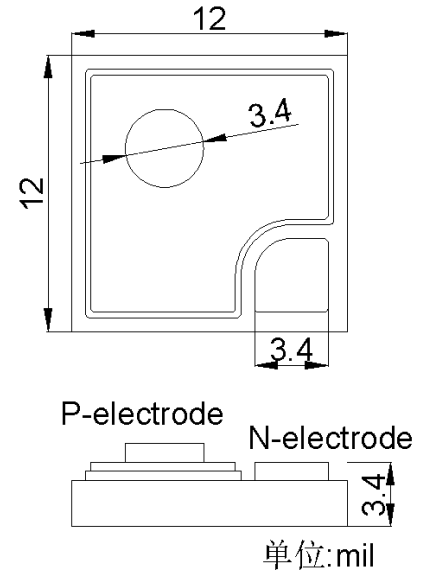


◆ 产品特点:

- 高亮度、长寿命
- 低电流驱动, 损耗小
- 户内外应用
- 芯片百分百测试分选
- 波长和光强良好一致性

◆ 物理参数:

P 电极	金
N 电极	金
芯片尺寸	12mil × 12mil (300 ± 20μm × 300 ± 20μm)
芯片厚度	3.4mil (85 ± 15μm)
焊盘尺寸	3.4mil (85 ± 10μm) in diameter



◆ 光电参数: (Tc=22°C, I_F=20mA)

产品型号	波长范围 (λ _D , nm)		工作电压 (V _F , V)	反向漏电流 (I _R , μA) @V _R =10V	半波宽度 (Δλ, nm)	最大电流 (I _F , mA) DC
	Min	Max				
S-12AGAUT*-515C***	515	517.5	≤3.4	≤2	≤30	30
S-12AGAUT*-517C***	517.5	520				
S-12AGAUT*-520C***	520	522.5				
S-12AGAUT*-522C***	522.5	525				
S-12AGAUT*-525C***	525	527.5				
S-12AGAUT*-527C***	527.5	530				

◆ 光强等级: (Tc=22°C, I_F=20mA)

等级	I	J	K	L	M	N
I _v (mcd)	160-200	200-240	240-300	300-360	360-420	420-500

◆ 其它说明

- 光电参数均系三安光电测试仪器在晶圆条件下的测试参数, 98%符合标称值范围
- 芯片封装工艺最高温度低于 280°C, 持续时间小于 10 秒
- GaN LED 芯片为静电敏感产品, 使用、运输时注意静电防护
- 主波长测量误差 ± 1.0nm
- 可根据客户需要订做特殊规格的芯片